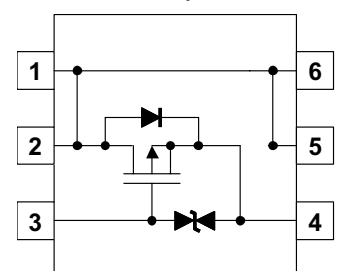


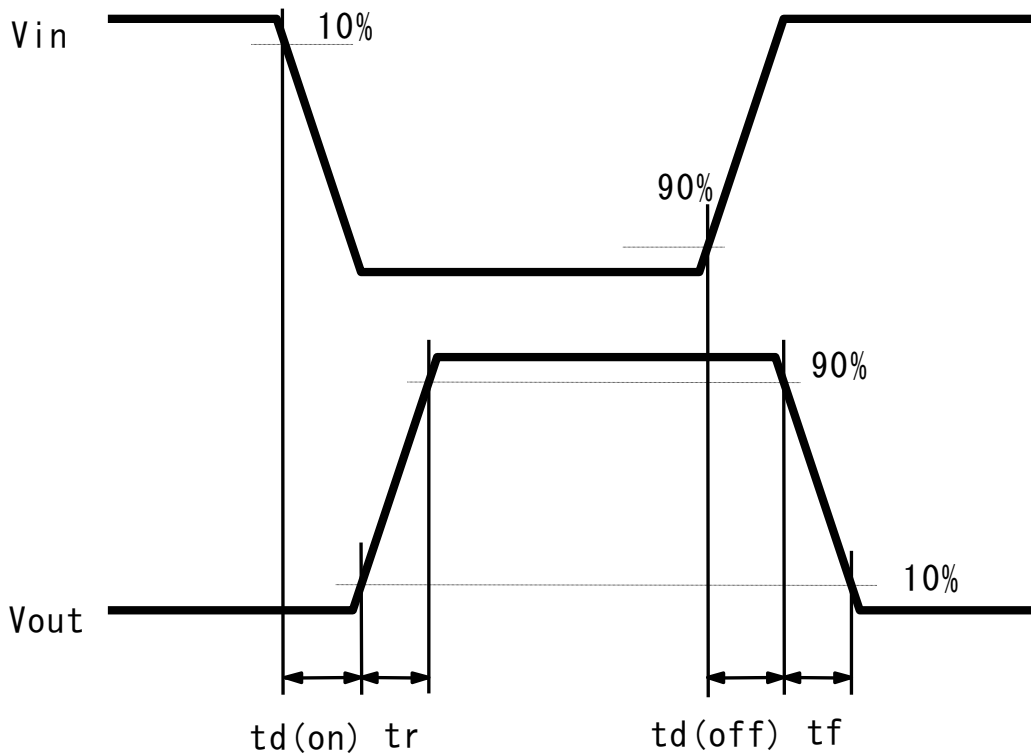
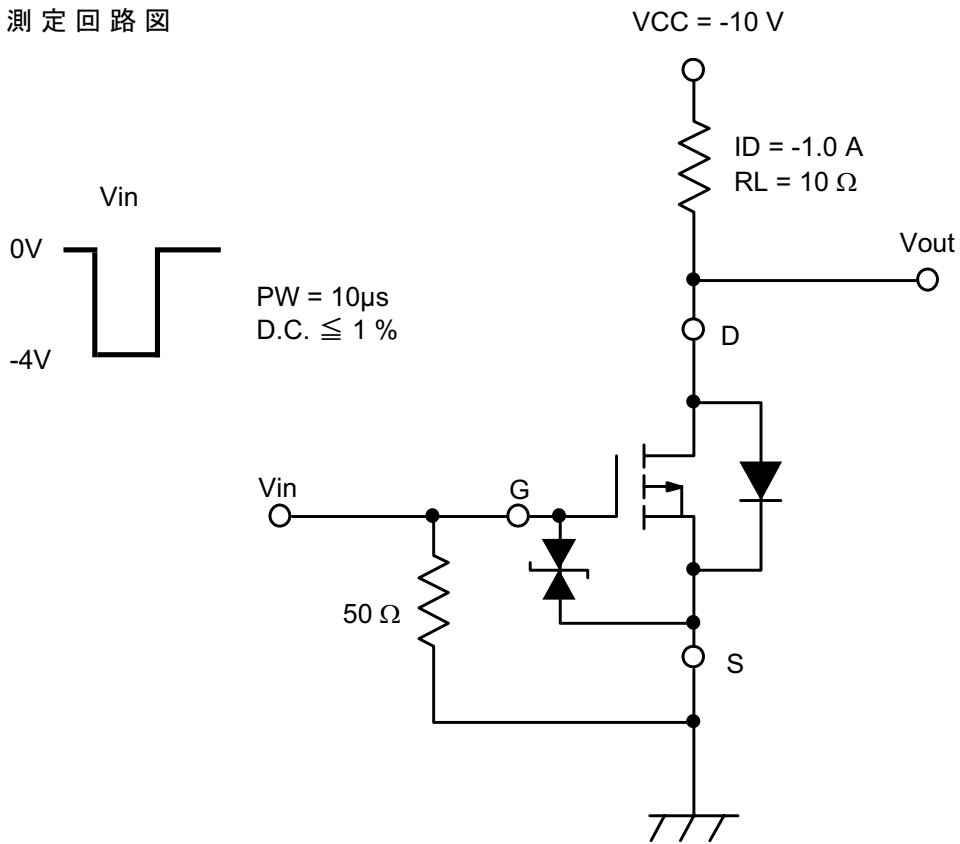
製品規格 / Product Specification		Prepared by	Checked by	Applied by	Established by		
品種名 / Type Number : M T M 8 6 1 2 7 0 \square B F *4		M.Taguchi	H.Tanida	H.Shidooka	K.Komichi		
種別 / Type	シリコン電界効果トランジスタ / Silicon Field Effect Transistors						
用途 / Application	スイッチング用 / Switching						
構造 / Structure	Pチャネル MOS 形 / P-Channel MOS Type						
外形 / Outline	WSSMini6-F1	マーク記号 / Marking			MK		
絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings	VDSS	VGSS	ID	IDp	*1 PD	Tch	Tstg
	-20	± 10	-2.0	-8.0	540	150	-55 to +150
	(V)	(V)	(A)	(A)	(mW)	($^{\circ}$ C)	($^{\circ}$ C)
電気的特性 / Electrical characteristics (Ta = 25 $^{\circ}$ C \pm 3 $^{\circ}$ C)							
項目 / Item	記号 / Symbol	測定条件 / Measuring condition	Limit			Unit	
			min.	typ.	max.		
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	VDSS	ID = -1.0 mA, VGS = 0 V	-20			V	
ドレイン・ソース遮断電流 Drain-Source Cutoff Current	IDSS	VDS = -20 V, VGS = 0 V			-1.0	μ A	
ゲート・ソース遮断電流 Gate-Source Cutoff Current	IGSS	VGS = ± 8 V, VDS = 0 V			± 10	μ A	
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	Vth	ID = -1.0 mA, VDS = -10 V	-0.4	-0.75	-1.1	V	
ドレイン・オン抵抗 1 Drain Resistance (ON) 1	RDS(ON) 1 *2	ID = -1.0 A, VGS = -4.0 V		80	120	m Ω	
ドレイン・オン抵抗 2 Drain Resistance (ON) 2	RDS(ON) 2 *2	ID = -1.0 A, VGS = -2.5 V		100	170	m Ω	
ドレイン・オン抵抗 3 Drain Resistance (ON) 3	RDS(ON) 3 *2	ID = -0.5 A, VGS = -1.8 V		140	230	m Ω	
伝達アドミタンス Forward Transfer Admittance	Yfs *2	ID = -1.0 A, VDS = -10 V, f = 1 kHz	3.0			S	
入力容量 Small-Signal Short-Circuit Input Capacitance	Ciss	VDS = -10 V, VGS = 0, f = 1 MHz		300		pF	
出力容量 Small-Signal Short-Circuit Output Capacitance	Coss	VDS = -10 V, VGS = 0, f = 1 MHz		30		pF	
帰還容量 Small-Signal Reverse Transfer Capacitance	Crss	VDS = -10 V, VGS = 0, f = 1 MHz		35		pF	
オン時遅延時間 Turn-on Delay Time	td(on) *3	VDD = -10 V, VGS = 0 to -4 V, ID = -1.0 A		6		ns	
立ち上がり時間 Rise Time	tr *3	VDD = -10 V, VGS = 0 to -4 V, ID = -1.0 A		8		ns	
オフ時遅延時間 Turn-off Delay Time	td(off) *3	VDD = -10 V, VGS = -4 to 0 V, ID = -1.0 A		57		ns	
立ち下り時間 Fall Time	tf *3	VDD = -10 V, VGS = -4 to 0 V, ID = -1.0 A		55		ns	
<p>Note: 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法による。 Measuring methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for transistors.</p> <p>*1 セラミックサブストレイト (40\times38\times0.2mm)上で測定 単体でのPD絶対最大定格は、150mW Measuring on Ceramic substrate at 40\times38\times0.2mm. Absolute maximum rating PD without heat sink shall be made 150mW.</p> <p>*2 Pluse test *3 測定回路参照 / Refer test circuit</p> <p>*4 包装 / Packing エンボスタイプ (熱圧着方式) Embossed Type (Thermo-compression sealing)</p>							
2008.1.9							
Established	Revised						

内部接続図 / Internally connected circuit



製品規格 / Product Specification
 品種名 / Type Number : M T M 8 6 1 2 7 0 L B F
 *4

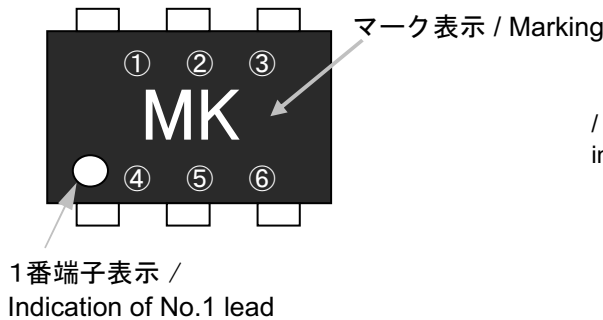
測定回路図



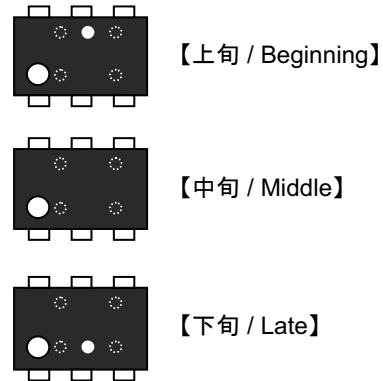
2008.1.9	
Established	Revised

製品規格 / Product Specification
 マーク図 / Mark Indication
 品種名 / Type Number : M T M 8 6 1 2 7 0 L B F
*4

マークレイアウト / Mark layout



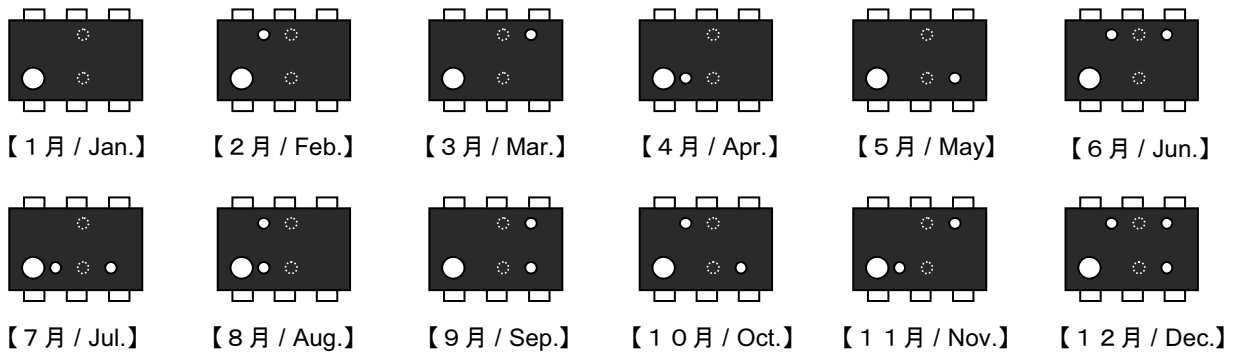
《②⑤：上・中・下旬別表示例
 / Example of indication of beginning/middle/late month indication》




①③④⑥：月別表示位置 / Indication of produced month
 ②⑤：上・中・下旬別表示位置
 Display position of beginning/middle
 /late month indication

実際の品名略号マークの字体は、この仕様で示されている字体と異なる場合があります。
 The actual font of product symbol may differ slightly from the font shown in this specification.

《月別表示例 / Example of indication of produced month》

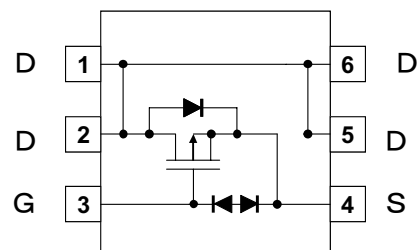


・工場区分マーク / Factory distinction mark

生産工場 / Factory	JAPAN		
パッケージコード / Package code	WSSMini6-F1		
表示マーク / Marking	表示無し/No indication 		

※ 白地：レーザーマーク部 / White parts are treated by laser mark.

ピン No / Lead No	接続電極 / Connection
1.	Drain
2.	Drain
3.	Gate
4.	Source
5.	Drain
6.	Drain



2008.1.9	
Established	Revised